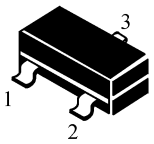
桂林斯壯微電子有限責任公司
Guilin Strong Micro-Electronics Co.,Ltd.

GMC2412K

SOT—23

1. BASE
2. EMITTER
3. COLLECTOR



■MAXIMUM RATINGS (T_a=25℃) 最大額定值

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Rating 額定值	Unit 單位
Collector-Base Voltage 集電極-基極電壓	V_{CBO}	60	V
Collector-Emitter Voltage 集電極-發射極電壓	V_{CEO}	50	V
Emitter-Base Voltage 發射極-基極電壓	V_{EBO}	7	V
Collector Current-Continuous 集電極電流-連續	Ic	150	mA
Collector Power Dissipation 集電極耗散功率	P_C	225	mW
Junction Temperature 結溫	T_j	150	℃
Storage Temperature Range 儲存溫度	T_{stg}	-55～150	℃

■DEVICE MARKING 打標

GMC2412K	Q	R	S
MARK	BQ	BR	BS
H_{FE}	120~270	180~390	270~560

GMC2412K

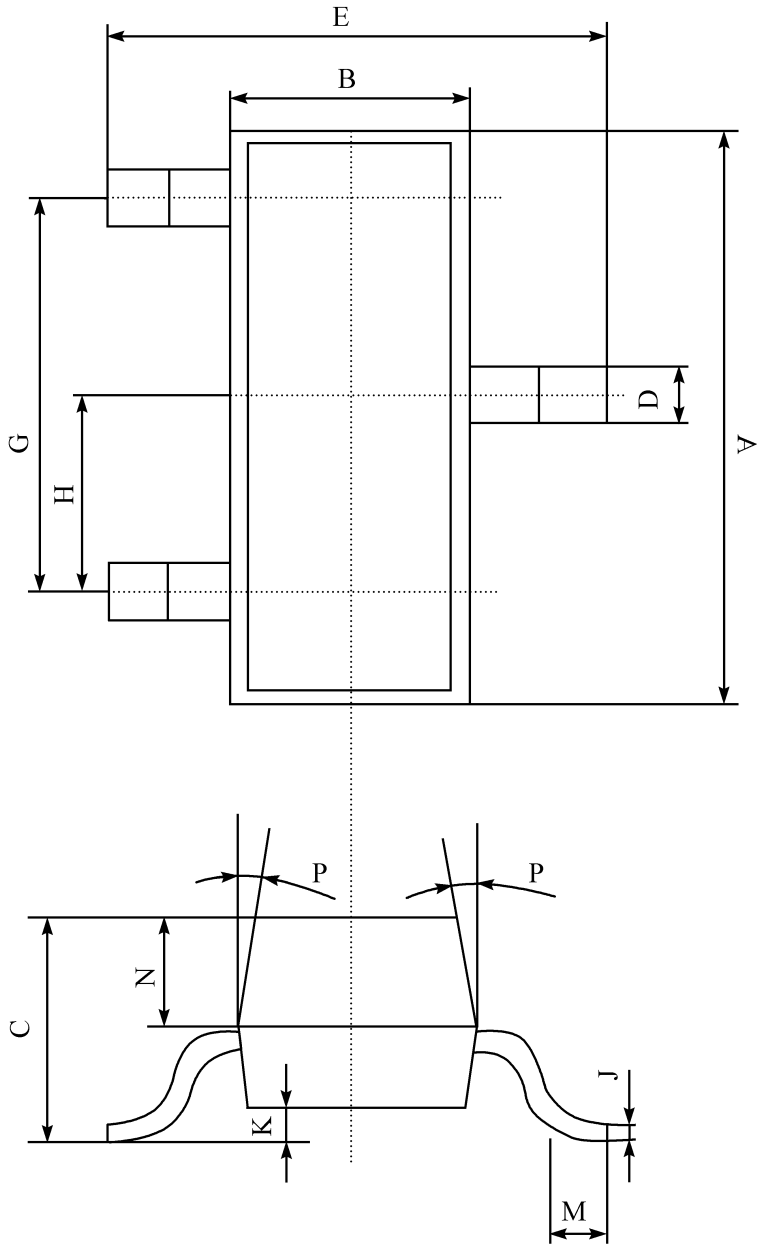
■ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

(T_A=25℃ unless otherwise noted 如無特殊說明,溫度爲 25℃)

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Test Condition 測試條件	Min 最小值	Typ 典型值	Max 最大值	Unit 單位
Collector Cutoff Current 集電極截止電流	I_{CBO}	V_{CB}=60V, I_E=0	—	—	0.1	μA
Emitter Cutoff Current 發射極截止電流	I_{EBO}	V_{EB}=7V, I_C=0	—	—	0.1	μA
Collector-Base Breakdown Voltage 集電極-基極擊穿電壓	$V_{(BR)CBO}$	I_C=50 μA	60	—	—	V
Collector-Emitter Breakdown Voltage 集電極-發射極擊穿電壓	$V_{(BR)CEO}$	I_C=1.0mA	50	—	—	V
Emitter-Base Breakdown Votlage 發射極-基極擊穿電壓	$V_{(BR)EBO}$	I_E=50 μA	7	—	—	V
DC Current Gain 直流電流增益	H_{FE}	V_{CE}=6V, I_C=1mA	120	—	560	—
Collector-Emitter Saturation Voltage 集電極-發射極飽和壓降	$V_{CE(sat)}$	I_C=50mA, I_B=5mA	—	—	0.4	V
Transition Frequency 特徵頻率	f_T	V_{CE}=12V, I_C=2mA, f=100MHz	—	180	—	MHz
Collector Output Capacitance 輸出電容	C_{ob}	V_{CB}=12V, I_E=0A, f=1MHz	—	2.0	3.5	pF

GMC2412K

■DIMENSION 外形封裝尺寸



序號	數值及公差
A	2.90±0.10
B	1.30±0.10
C	1.00±0.10
D	0.40±0.10
E	2.40±0.20
G	1.90±0.10
H	0.95±0.05
J	0.13±0.05
K	0.00-0.10
M	≥0.2
N	0.60±0.10
P	7±2°